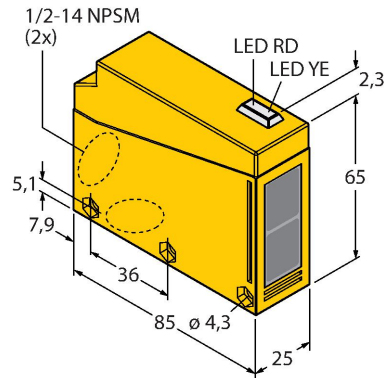


Q853E-B

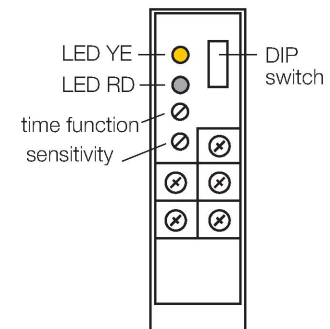
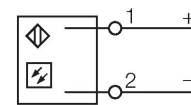
Senzor fotoelectric – Senzor în opoziție (emițător)



Caratteristici

- Cameră de borne integrată
- Presetupe, montare cu offset de 90° în două locuri
- Grad de protecție IP67
- Tensiune de alimentare: 12...240 Vcc, 24...240 Vca

Diagramă de conexiuni

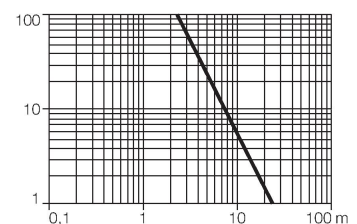


Caracteristici tehnice

Tip	Q853E-B
Nr. ID	3031649
Date optice	
Funcție	Senzor în opoziție
Mod de operare	Emițător
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	680 nm
Domeniu	0...23000 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	12...240 Vcc
Tensiune de alimentare	24...240 Vca
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 3000 mA
Curent nominal în c.a.	≤ 3000 mA
Timp de întârziare la alimentare	≤ 0 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 20 ms
Opțiuni de setare	Potențiometru
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, Q85
Dimensiuni	85 x 65 x 25 mm
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastic, Galben
Lentilă	acrilic, Acrylic
Conexiune electrică	Bloc de terminale
Număr de conductoare	2
Temperatura mediului	-25...+55 °C
Clasă de protecție	IP67
Excess gain indication	LED

Principiu de funcționare

Senzorii în opoziție sunt alcătuiți din emițător și receptor separați. Aceștia sunt montați fața în față astfel încât lumina de la emițător sa cada direct pe receptor. Când un obiect întrerupe sau micșorează intensitatea luminii, senzorul comută. Senzorii în opoziție constituie cel mai bun mod de detecție pentru obiecte opace. Acest mod de detecție oferă un contrast excelent între condițiile obturat (dark) și neobturat (light) precum și un excelent raport "excess gain", permițând utilizarea pentru distanțe foarte mari și condiții dificile de mediu, exp. murdărie acumulată pe lentilă sau senzori nealinați.



Caracteristici tehnice

Teste/Certificări